# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-277814

(43)Date of publication of application: 06.10.2000

(51)Int.CI.

H01L 33/00 G02B 6/42 H01L 31/02

(21)Application number: 11-086306

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

29.03.1999

(72)Inventor: TAKAGI DAISUKE

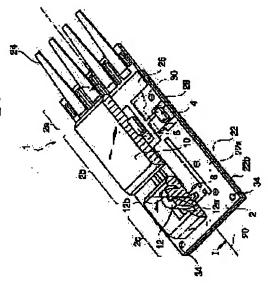
#### (54) OPTICAL COMMUNICATION MODULE

#### (57)Abstract:

module, the function of which can be improved. SOLUTION: An optical communication module 1 is provided with a flexible printed board 2 carrying a first conductive layer, semiconductor electronic devices 4 and 6, and a semiconductor optical device 8. The optical device 8 is mounted on the printed board 2 and emits or receives light having a prescribed wavelength. The electronic devices 4

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an optical communication

optical device 8 is mounted on the printed board 2 and emits or receives light having a prescribed wavelength. The electronic devices 4 and 6 are mounted on the printed board 2 and electrically connected to the optical device 8 via the first conductive layer formed on the printed board 2. The optical device 8 and electronic devices 4 and 6 are sealed with sealing resins 10 and 12.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-277814 (P2000-277814A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.Cl."	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H01L 33/00		H01L 33/00	N 2H037
G 0 2 B 6/42		G 0 2 B 6/42	5 F O 4 1
H01L 31/02		H 0 1 L 31/02	B 5F088

#### 審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 10 頁)

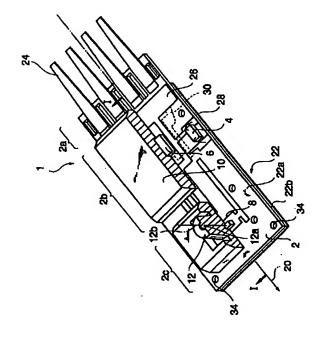
		国工的4、不断4、 附外外9数10 OE (至 10 页)
(21)出顧番号	<b>特顧平11-86306</b>	(71)出願人 000002130 住友電気工業株式会社
(22)出顧日	平成11年3月29日(1999.3.29)	大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番33号
(GE) MRM H	,,	(72)発明者 高木 大輔 神奈川県横浜市柴区田谷町1番地 住友電 気工業株式会社横浜製作所内 (74)代理人 100088155
		弁理士 長谷川 芳樹 (外4名) Fターム(参考) 2H037 AA01 BA03 BA11 DA03 DA05 DA06
		5F041 AA31 DA43 DA83 EE03 FF14

# (54)【発明の名称】 光通信モジュール

## (57)【要約】

【課題】 高機能化を図ることが可能な光通信モジュールを提供する。

【解決手段】 本発明に係わる光通信モジュール1は、第1の導電層を有するフレキシブルブリント基板2と、半導体電子デバイス4、6、半導体光デバイス8ととを備える。半導体光デバイス8は、フレキシブルブリント基板2上に搭載され所定波長の光を発光叉は受光する。半導体電子デバイス4、6は、フレキシブルブリント基板2上に搭載されフレキシブルブリント基板2上の第1の導電層を介して半導体光デバイス8に電気的に接続されている。半導体光デバイス8および半導体電子デバイス4、8は封止用樹脂10、12を用いて封止されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の導電層とこの第1の導電層を支持する絶縁性基体を有するフレキシブルブリント基板と、前記フレキシブルブリント基板上に搭載され前記第1の 導電層と電気的に接続され所定波長の光を発光叉は受光する半導体光デバイスと。

前記フレキシブルブリント基板上に搭載され前記第1の 導電層および前記半導体光デバイスに電気的に接続され た第1の半導体電子デバイスと、を備え、

前記半導体光デバイスはモールド封止され、また前記第 10 1 の半導体電子デバイスはモールド封止されている、光 通信モジュール。

【請求項2】 前記フレキシブルプリント基板の前記絶縁性基体は、前記第1の導電層が設けられた第1の面と、前記第1の面と対向する第2の面を備え、

前記第2の面は第2の導電層を有する、ことを特徴とする請求項1に記載の光通信モジュール。

【請求項3】 前記フレキシブルブリント基板は、前記 第1の面と前記第2の面との間に設けられた第3の導電 層を有する、ととを特徴とする請求項2に記載の光通信 20 モジュール。

【請求項4】 前記半導体光デバイスは、前記所定波長の光が透過する封止用樹脂を用いてモールド封止されている、ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の光通信モジュール。

【請求項5】 前記モールド封止のための樹脂体を利用して形成され前記半導体光デバイスと光学的に結合されるレンズが設けられている、ことを特徴とする請求項4 に記載の光通信モジュール。

【 請求項 6 】 前記第 1 の半導体電子デバイスは素子が 形成された素子形成面を有し、前記素子形成面は前記フ レキシブルブリント基板に対面している、ことを特徴と する請求項 1 から請求項 5 のいずれかに記載の光通信モ ジュール。

【請求項7】 前記フレキシブルブリント基板は、前記 半導体光デバイスとフレキシブルブリント基板とが位置 合わせされた状態で前配半導体光デバイスをモールド封 止することを可能にするための位置合わせ手段を有す る、ことを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか に記載の光通信モジュール。

【 請求項8 】 前記第1の半導体電子デバイス及び前記 半導体光デバイスの少なくともいずれか一方と電気的に 接続された第2の半導体電子デバイスを備え、

前記半導体光デバイス、前記第1の半導体電子デバイス、および前記第2の半導体半導体電子デバイスは、前記フレキシブルブリント基板の一主面上に搭載され、前記フレキシブルブリント基板は、前記主面、および前記主面と対向する裏面、のいずれかを対面させるように屈曲され、

前記第1の半導体電子デバイスおよび前記第2の半導体 50

半導体電子デバイスは、一体にモールド封止されている、ことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか に記載の光通信モジュール。

【請求項9】 半導体電子デバイスを封止する第1の樹脂体が設けられた第1の領域、半導体光デバイスを封止する第2の樹脂体が設けられた第2の領域、前配第1の領域および前配第2の領域の間に設けられ可撓性を有する第1のネック領域、並びに前配半導体電子デバイスおよび前配半導体光デバイスを接続する少なくとも一層以上の導電層を有するフレキシブルプリント基板を備える光通信モジュール。

【請求項10】 前記フレキシブルブリント基板は、リード端子が設けられた端子辺、並びに第1の樹脂体および前記第2の樹脂体のいずれかと前記端子辺との間に設けられた可撓性を有する第2のネック領域を有する、請求項9に記載の光通信モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光通信モジュールに 関し、特に、フレキシブルブリント基板上に搭載された 半導体光デバイス及び半導体電子デバイスを備える光通 信モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の光リンクには、以下のようなもの があった。

【0003】特開平10-123376号公報には、光リンクに使用されるリードフレームに関する技術が記載されている。そのリードフレームは、光素子搭載部、電子素子搭載部、およびこの両部を電気的に接続し所定の形状を保持するための接続部を有する。リードフレームの光素子搭載部には光素子を搭載し、電子素子搭載部には電子素子を搭載している。電子素子搭載部および光素子搭載部には、光素子および電子素子を電気的に接続するために配線リードが形成され、これらの各部は個別に樹脂封止されている。この光リンクでは、接続部を鉤型に折り曲げることによって光素子の光軸の方向を光ファイバに向けている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】とのリードフレームでは、配線リードは外部リードピンも兼ねている。とのため、機械的な強度の点から、微細な配線を形成するためにリードフレーム用金属板の厚さを薄くすることにも限界がある。配線リードの強度が不十分であると、樹脂モールドの際に配線リードが変形してしまう可能性もある。

【0005】また、リードフレームは、薄い金属板から エッチングによって形成されるので、製作方法に起因す る微細化の限界も存在する。

【0006】リードフレームは、所望の形状の配線リー ド及びダイパッドを有している。しかしながら、リード

40

フレームは単一の金属板から形成されるので、リードフレーム上に搭載される素子間を接続するために多層の導 電層を使用できない。

【0007】一方、光リンクの高機能化を図るためには、より複雑で微細な配線パターンを形成可能な構造が必要である。

【0008】そこで、本発明の目的は、高機能化を図る ことが可能な光通信モジュールを提供することにある。 【0009】

【課題を解決するための手段】発明者は、このような課 10 題を解決しつつ、更に今後の光通信の高速化にも対応可 能な光通信モジュールについて検討を重ねた。

【0010】高速な光通信を行うためには、ノイズ特性を良好にすることが重要である。このためには、GND配線を強化する必要がある。しかしながら、リードフレームでは、GND電位の強化にも限界がある。

【0011】また、従来と同様に光デバイスおよび半導体電子デバイスを樹脂封止することも必要である。

【0012】以上のことを検討した結果、本発明を次のようにした。

【0013】本発明に係わる光通信モジュールは、フレキシブルブリント基板と、半導体光デバイスと、半導体電子デバイスとを備える。半導体光デバイスは、フレキシブルブリント基板上に搭載され所定波長の光を発光叉は受光する。半導体電子デバイスは、フレキシブルブリント基板上に搭載されている。半導体光デバイスはモールド封止されている。半導体光デバイスは、フレキシブルブリント基板上において半導体電子デバイスと電気的に接続されている。

【0014】フレキシブルブリント基板は、第1の導電 層および絶縁性の基体を有する。フレキシブルブリント 基板の第1の導電層は基体によって支持されているので、導電層の機械的強度は基体によって補強される。 とのため、リードフレームのように配線リードの機械的強度を考慮することなく、フレキシブルブリント基板上に 微細な配線を形成できる。

【0015】とのような光通信モジュールでは、半導体電子デバイスおよび半導体光デバイスをフレキシブルブリント基板の同一面に搭載するととができる。

【0016】本発明の光通信モジュールでは、フレキシブルブリント基板の絶縁性基体は、第1の導電層が設けられた第1の面と、第1の面と対向する第2の面を備え、第2の面は第2の導電層を有することができる。また、フレキシブルブリント基板は、第1の面と第2の面との間に導電性を有する第3の導電層を有することができる。第3の導電層は、第1の導電層及び第2の導線層と異なる導電層である。このため、フレキシブルブリント基板では、多層化された導電層を利用できる。複雑で微細な配線バターンを実現することが可能になる。

【0017】第1の導電層、第2の導線層及び第3の導電層は、例えば接続ピア等によって意図的に接続される場合を除き、基体によって絶縁されている。

【0018】本発明の光通信モジュールでは、半導体光デバイスをモールド封止するための樹脂体、および半導体半導体電子デバイスをモールド封止するための樹脂体を有することができる。半導体光デバイスは、所定波長の光に透明な封止用樹脂から形成された樹脂体で封止されることができる。この樹脂体は、トランスファモールド法で形成されることができる。この樹脂体の形状を利用して、半導体光デバイスと光学的に結合可能なレンズを設けることができる。このレンズを用いると、半導体光デバイスが受光デバイスの場合には、その受光面に光を集光可能になり、半導体光デバイスが発光デバイスの場合には、この発光デバイスと光学的に結合する光導波路といった光学デバイスに光を集光可能になる。

【0019】本発明の光通信モジュールでは、半導体電子デバイスの素子形成面がフレキシブルブリント基板に対面していることが好ましい。このような光通信モジュールでは、半導体光デバイスが受光または出射する光が、ノイズ光として、素子形成面に形成されている素子に直接に到達しない。このため、ノイズ光が半導体電子デバイスの動作へ影響することを防止できる。

【0020】本発明の光通信モジュールでは、フレキシブルプリント基板は、半導体光デバイスを封止することを可能にするための位置合わせ手段を有することができる。位置合わせ手段は、半導体光デバイスとフレキシブルブリント基板とを確実に位置合わせすること可能にする。このような位置合わせ手段として、例えばフレキシブル基板に形成された貫通孔を適用できる。

【0021】本発明の光通信モジュールでは、第1の半導体電子デバイス及び半導体光デバイスの少なくともいずれか一方と電気的に接続された第2の半導体電子デバイスを備えることができる。半導体光デバイス、第1の半導体電子デバイス、および第2の半導体半導体電子デバイスは、フレキシブルブリント基板の一主面上に搭載される。フレキシブルブリント基板は、一主面、およびこの主面と対向する裏面、のいずれかを対面するように屈曲された状態で、第1の半導体電子デバイスおよび第2の半導体半導体電子デバイスが一体にモールド封止されていることができる。

【0022】複数の半導体電子デバイスをフレキシブルブリント基板に搭載し一体の樹脂体で封止しているので、半導体電子デバイスの搭載部分を小型化しつつ、光通信モジュールの高機能化を図ることができる。また、フレキシブルブリント基板を用いているので、一体の樹脂体を形成するときにも、基板を容易に屈曲できる。樹脂体が形成されていないフレキシブルブリント基板の部分は可撓性を有したままである。故に、モールド封止用金型にフレキシブルプリント基板を配置する際にフレキ

シブルブリント基板が容易に屈曲する。とのため、予め 金型に合うように屈曲する工程が必要なリードフレーム を用いる場合に比べて製造工程が簡素にできる。

【0023】本発明の光通信モジュールは、半導体電子 デバイスを封止する第1の樹脂体が設けられた第1の領 域、半導体光デバイスを封止する第2の樹脂体が設けら れた第2の領域、第1の領域および第2の領域の間に設 けられ可撓性を有する第1のネック領域、および半導体 電子デバイスおよび前記半導体光デバイスを接続する少 なくとも一層以上の導電層を有するフレキシブルブリン 10 有する第1のネック領域が形成される。第1の領域2 a ト基板を備える。このようなフレキシブルブリント基板 は、リード端子が設けられた端子辺、および第1の樹脂 体および第2の樹脂体のいずれかと、端子辺との間に設 けられた可撓性を有する第2のネック領域を有すること ができる。これによって、光通信モジュールの完成した 後にも、ネック領域を繰り返し屈曲させることができ る。フレキシブルプリント基板の第1の領域は、リード 辺と第2の領域との間に設けられていることが好適であ る。

#### [0024]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面を参照 しながら説明する。可能な場合には、同一および類似の 部分には同一の符号を付して重複する説明を省略する。 【0025】図1は、本発明の光通信モジュールの斜視 図である。図1では、光通信モジュールの内部が明らか になるように一部破断図にしている。 図1を参照する と、光通信モジュール1は、フレキシブルプリント基板 2と、半導体電子デバイス4、6と、半導体光デバイス 8と、半導体電子デバイス4、6を封止する第1のモー ルド樹脂体10と、半導体光デバイス8を封止する第2 のモールド樹脂体12と、を備える。半導体電子デバイ ス4、8および半導体光デバイス8は、基体22の第1 の面22a上に搭載されている。

【0026】フレキシブルブリント基板2は、基体2 2、リード端子24、第1の導電層26、第2の導電層 28、および第3の導電層30を備える。基体22の一 辺には、複数のリード端子24が設けられている。リー ド端子24は、実装基板(図示せず)に接続され電気的 な信号の伝達を可能にする。基体22は、第1の導電層 28、第2の導電層28、および第3の導電層30をそ れぞれ電気的に絶縁する。基体22は、矩形のフィルム であって、可撓性を有する。基体22は、リード端子2 4、第1の導電層26、第2の導電層28、および第3 の導電層30を支持できるような機械的な強度を有する 支持部材でもある。との支持部材は、電気的な絶縁性を 有する。この様な支持部材を使用すると、各配線層2 6、28、30は、最小幅0.1mm程度までも傲細化 を可能にする。

【0027】基体22は、所定の軸20方向に沿って第 1の領域2a、第2の領域2b、および第3の領域2c

を有する。第1の領域2 a には、フレキシブルブリント 基板の一辺に設けられるリード端子24を有する。 第2 の領域2bには、半導体電子デバイス4、8を封止する ための樹脂体10を有する。第3の領域2cには、半導 体光デバイス8を封止するための樹脂体12を有する。 第2の領域2bと第3の領域2cとの間には、樹脂体1 0が搭載されているフレキシブルブリント基板2の表面 と、樹脂体12が搭載されているフレキシブルブリント 基板2の表面との角度を変更可能にするような可撓性を と第2の領域2bの間には、複数のリード端子24を含 む面と、樹脂体10が搭載されているフレキシブルブリ ント基板2の表面との角度を変更可能にするような可撓 性を有する第2のネック領域が形成される。 このような 第1および第2のネック領域は、実装基板に搭載された 後に、光通信モジュール1が光コネクタ (図示せず) と 結合される際に接続形態を多様にするために役立つ。樹 脂体10、12は、基体22の機械的な強度も補強して いる。

20 【0028】図2は、図1のI-I断面での光通信モジ ュール1の断面図である。図1および図2を参照しなが ら、第1の導電層26、第2の導電層28、および第3 の導電層30について説明する。第1の導電層26は、 基体22の第1の面22a上に形成されている。第2の 導電層28は、基体22の第2の面22b上に形成され ている。第3の導電層30は、基体22の第1の面22 aと第2の面22bとの間に形成されている。第1の導 電層26、第2の導電層28、および第3の導電層30 の各々は、リード端子24、半導体電子デバイス4、 6、および半導体光デバイス8を相互に電気的に接続す るために所定のパターンに形成された金属薄膜である。 第1の導電層26、第2の導電層28、および第3の導 電層30は、それぞれ、絶縁部材22cに設けられたビ ア孔22dを介して相互に電気的に接続されることがで

【0029】好適な実施の形態としては、半導体電子デ バイス4、6および半導体光デバイス8を相互に接続す るための配線として第1の導電層28および第3の導電 層30を使用し、また、光通信モジュール1の基準電位 (接地、GND)を強化するために第2の導電階28を 使用することが好ましい。このようにすれば、光通信モ ジュール 1 の髙機能化を達成するために複数の配線層を 使用でき、加えて、ノイズ特性を良好にするために基準 電位を強化するとと、つまりインビーダンスを整合する ことも達成できる。 基準電位の強化のためには、例え ぱ、GNDプレーンを広く、厚く形成することができ る。これら第1の導電層26、第2の導電層28、およ び第3の導電層30の薄膜としては、銅(Cu)薄膜を 使用できる。第1の導電層26と第2の導電層28との 50 間には、フレキシブルブリント基板のフレキシビリティ

を犠牲にすることがない程度に複数の導電層を備えることは可能である。

【0030】再び、図1を参照すると、半導体電子デバ イス4、6は、半導体光デバイス8から受けた電気信号 を処理することができる。この処理された信号は、リー ド端子24を介して光通信モジュール1から出力され る。また、半導体電子デバイス4、6は、リード端子2 4を介して光通信モジュール1の外から受けた電気信号 を処理し、基体22上の配線層を介して半導体光デバイ ス8を駆動することができる。半導体電子デバイス4、 6は、受けた信号を所定の処理を行い出力する信号処理 デバイス、例えばアナログ信号処理が可能なデバイス、 デジタル信号処理が可能なデバイス、前置増幅器、等で 有り得る。フレキシブルプリント基板2上に搭載される 電子デバイスとしては、トランジスタを有する半導体能 動デバイスだけでなく、チップ抵抗、チップコンデン サ、半固定抵抗といった受動デバイス等がある。このよ うに、受動デバイスを搭載すると、例えば、半導体光デ バイス8の電源ラインに近接した位置に電源パイパスコ ンデンサ等の電子素子を一緒に接続し、素子間の接続距 20 離を短縮することによって雑音特性の改善を図ることが

【0031】再び、図2を参照すると、半導体電子デバ イス6の素子形成面6aは、フレキシブルブリント基板 2の第1の面(デバイス実装面)22aと対面してい る。つまり、半導体電子デバイス6は、フリップチップ 実装されている。 このために、 半導体電子デバイス6の 素子形成面6a上のバッド部には、バンブのための接続 部材14が形成され、これと第1の配線層26とが電気 的に接続される。LCC (Leadless Chip Charier) の 形態を採用すると、半導体電子デバイス6の素子形成面 6aが基体22の表面22aと対面する。このため、半 導体光デバイス8が出射する光または受ける光が半導体 電子デバイス6の素子形成面6 a に直接に到達しない。 故に、ノイズ光は、半導体電子デバイス6の動作へ影響 しない。一方、半導体電子デバイス4は、索子形成面に 対向する面をフレキシブルブリント基板2のデバイス実 装面22aに対面させるように搭載されている。半導体 電子デバイス4は、フレキシブルブリント基板2上の所 定の位置に搭載された後に、フレキシブルブリント基板 2上に配線とボンディングワイヤを用いて電気的に接続

【0032】半導体光デバイス8は、発光素子および受光素子の少なくともいずれかである。発光素子としては、半導体レーザ、発光ダイオード等がある。受光素子としては、pinフォトダイオード、アバランシェフォトダイオード等がある。半導体光デバイス8は、フレキシブルブリント基板2上に配線層に対してボンディングワイヤで電気的に接続されている。半導体光デバイス8は、必要に応じてチップキャリア等に搭載された状態で 50

フレキシブルブリント基板2上に搭載されることもできる。光通信モジュール1は、半導体光デバイス8に加えて、別個の半導体光デバイスを含むことができる。

【0033】半導体電子デバイス4、6は、第2の樹脂体10によってモールド封止されている。半導体光デバイス8は、第1の樹脂体12によってモールド封止されている。第2の樹脂体10としては、半導体光デバイス8が発光叉は受光する所定波長の光に不透明な樹脂を用いる。一方、第1の樹脂体12としては、半導体光デバイス8が発光叉は受光する所定波長の光に対して透明な樹脂を用いる。このため、第2の樹脂体10は、所定の波長の光に対する光透過率に関して、第1の樹脂体12に比べて小さい。このような樹脂体10、12は、例えばトランスファモールド法を用いて形成される。

【0034】第1の樹脂体12は、半導体光デバイス8が発光または受光する光を集光するための集光手段12 aを有することができる。集光手段12aとしては、樹脂体の外部形状を利用して形成されるレンズがある。レンズ12aが十分な集光機能を発揮するために、レンズ12aが光前となり、半導体光デバイス8の発光面または受光面と交差する必要がある。このために、半導体光デバイス8の位置は、第1の樹脂体12の位置と相対的に位置合わせされている必要がある。

【0035】 これを確実に行うために、フレキシブルブリント基板2は、位置合わせ手段34を有する。位置合わせ手段34は、半導体光デバイス8とフレキシブルプリント基板2とが位置合わせされた状態の下に、封止用樹脂を用いて半導体光デバイス8を封止することを可能にする。このような位置合わせ手段34は、区1に示された実施の形態では、位置合わせ手段34は、基板22の第1の面22aから第2の面22bに貫通する位置合わせ孔34である。

【0036】図3は、半導体光デバイス8が搭載されたフレキシブルブリント基板2、およびトランスファモールド金型35を部分的に示している。金型35は、位置決め手段36は、フレキシブルブリント基板2の位置合わせ手段34と組み合わされて、フレキシブルブリント基板2を金型35に位置合わせすることを可能にする。図3に示された実施の形態では、位置決め手段34は、基板搭載面37上に設けられた複数の突起部(ピン)36である。複数の突起部36は、フレキシブルブリント基板2の対応する位置合わせ孔34に挿入され、半導体光デバイス8と樹脂体12との相対的な位置を規定する。このような突起部36は、半導体電子デバイス4、6と樹脂体10との相対的な位置を規定するためにも利用できる。

【0037】フレキシブルプリント基板2は、樹脂体10、12の形成領域に孔38を有することができる。この孔38を含む領域に樹脂体を形成すると、孔38内に樹脂体10、12が設けられる。このため、樹脂体1

10

0、12がフレキシブルプリント基板2に十分に固定される。この固定によって、フレキシブルプリント基板2の機械的な強度が増す。

【0038】図4は、樹脂封止された光通信モジュールを示す斜視図である。光通信モジュール 1 を樹脂封止するためには、例えば以下の手順による。

【0039】所定の金型(図示せず)を用いて、フレキシブルブリント基板2の第2の領域2bを封止用樹脂でモールドすることによって、その領域内に存在する半導体電子デバイス8および受動素子、並びにボンディング 10ワイヤ等を樹脂封止する。このための封止用樹脂は、半導体光デバイス8に係わる光の波長に対して光透過性を有していないので、封止された素子を外光から遮光する。

【0040】別の金型(図3の35)を用いて、フレキシブルブリント基板2の第3の領域2cを封止用樹脂でモールドすることによって、その領域内に存在する半導体光デバイス8および受動素子、並びにボンディングワイヤ等を樹脂封止する。このための封止用樹脂は、半導体光デバイス8に係わる光の波長に対して光透過性を有20する。既に説明したように、この金型でモールド成型すると、半導体光デバイス8の主面に対応するように集光レンズ12aが一体に樹脂成型される。

【0041】第1の領域2aのモールド樹脂形成と、第2の領域2bのモールド樹脂形成とを別々に行う場合を説明したけれども、一つの金型を用いてモールド成型することができるので、これらの樹脂形成を同時に一括して行うことができる。このとき使用される封止用樹脂は、半導体光デバイスに係わる光の波長に対して光透過性を有する。このため、半導体電子デバイス4、6の部 30分に光を遮蔽するための手段、例えば、遮光性を有する筐体等を設けることが望ましい。

【0042】以上、説明したように本発明では、フレキシブルブリント基板2を用いているので、リードフレームを用いる場合に必要な樹脂形成後のリード形成工程が不要になる。また、樹脂体10と樹脂体12とを所定の位置関係に配置するために、従来では、リードフレームの接続部を曲げる工程が必要であった。しかしながら、本発明の光通信モジュールでは、そのような工程は必要ない。

【0043】図5は、別の実施の形態の光通信モジュールの断面図である。図5では、図1のI-I断面に相当 る場合を説明したする断面を示し、ネック領域2 d、2 e k て屈曲された状態を示している。破線は、第3の領域2 c が屈曲される前の状態を示している。図5を参照すると、光通信モジュール41では、第3の領域2 c kモールド成型される樹脂体42の形状は、図1k示された光通信モジュー 説明する。図8 k 3の間は2 c k 2の形状と異なる。樹脂体42の形状された樹脂体12の形状と異なる。樹脂体42 c を備える。図9は、光道図5では、集光レンズ42 a および結合部42 c の形状 50 面を示している。

は、軸42bを中心に回転対称である。

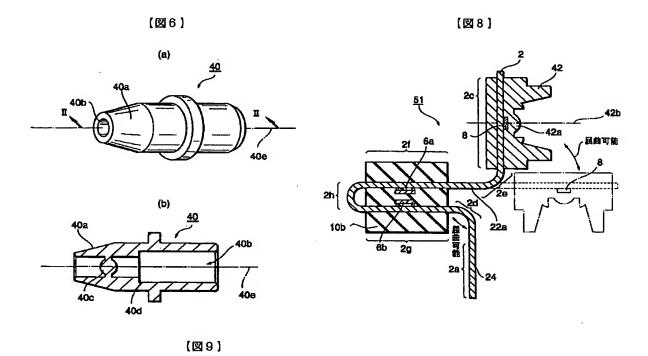
【0044】集光レンズ42 a は、その光軸42 b が半導体光デバイス8の光出射端(光出射面)叉は受光端(受光面)と交差するように設けられている。結合部42 c は、円錐状の内壁を有する凹部42 d を含む。この凹部42 d は、集光レンズ42 a に向かうにつれて軸42 b を中心にする内径が次第に小さくなる。結合部42 の凹部42 d に、後述するスリーブ(図6(a) および図6(b)の40)をはめ込むことができる。

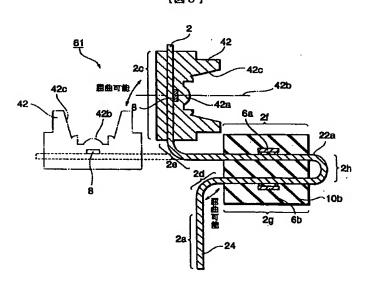
【0045】図6(a)は、スリーブの斜視図である。 図6 (b) は、図6 (a) の11-11断面における断 面図である。スリーブ42は、金属またはブラスチック 等の樹脂から成型された円筒状の部品である。スリーブ 40の先端部40 aは、結合部42の凹部42 dの内壁 に嵌め合されるような形状に形成されている。このた め、スリーブ42は、その先端に近づくにつれて次第に 外形が小さくなる円錐台状に形成されている。スリーブ 40は、所定の軸42eに沿って伸び、その中心には中 心孔40 bを有する。先端部分40 a に設けられた中心 孔40 b内には、レンズ40 cが設けられている。先端 部分40aと対向する他端には、所定の軸に沿って所定 の長さ伸びる挿入孔40bが設けられている。挿入孔4 0 b の他端には、挿入孔4 0 b の挿入されるフェルール 端部を接触させてフェルールの位置決めを行うための段 部40 dが設けられている。

【0046】図7は、スリーブ40の先端部40aを光通信モジュール41の結合部42の凹部42dに挿入した状態を示す断面図である。なお、光通信モジュール41は、図1のI-I断面における断面図であり、スリーブ40は、図6(b)のII-II断面における断面図である。図7を参照すると、凹部42dの内壁と先端部40aの外壁とがはめ合わされると、スリーブ40は、光通信モジュール41に対して位置決めされる。とれによって、レンズ42aの軸42bとスリーブ40の軸40eとが一致する。光ファイバを保持するフェルール44をスリーブ40の後端から中心孔40bに挿入すると、光ファイバの光が伝搬する方向を示す軸44aは、レンズ42aの軸42b及びスリーブ40の軸40eに一致する。

40 【0047】スリーブ40を用いて光通信モジュール4 1の半導体光デバイス8を光ファイバに光学的に結合す る場合を説明した。しかしながら、別個の構成を有する 光コネクタを用いて、光通信モジュール1、41を光コ ネクタと結合させることも可能である。

【0048】図8および図9を参照しながら、本発明の別の実施の形態の光通信モジュール51、61について説明する。図8は、光通信モジュール51の断面図である。図9は、光通信モジュール61の断面図である。図8および図9は、図1におけるI-I断面に相当する断面を示している。





でモールド封止している。故に、電子部品の搭載数を増 加させることができ、且つ光通信モジュール51、61 が実装基板上において占める面積の増大を抑えるととが できる。

12

【0049】図8および図9を参照すると、フレキシブ ルブリント基板2の一主面(基体22の表面22a)上 に半導体電子デバイス 6 a 、 6 b および半導体光デバイ ス8を備える。既に説明したように、フレキシブルブリ ント基板2は、リード端子24が設けられている第1の 領域2a、半導体光デバイス8をモールド封止する樹脂 体42が設けられている第3の領域2cを備える。フレ キシブルブリント基板2は、更に、第1の領域2 a およ び第3の領域2cの間に、第4の領域2f、第5の領域 2g、および第6の領域2hを備える。第6の領域2h 10 は、第4の領域2gと第5の領域2gとの間に設けられ ている。第4の領域2 f および第5の領域2 g には、そ れぞれ半導体電子デバイス6a、6bが搭載されてい る。半導体電子デバイス6a、6bは、フレキシブルブ リント基板2の第1の面(基体22の表面22a) に素 子形成面が対面するようにフリップチップ実装されてい

【0053】樹脂体10aと樹脂体42との間、または 樹脂体10bと樹脂体42との間にネック領域2eが設 けられるので、半導体光デバイス8が、光導波路といっ た光学デバイスと結合することを容易にしている。

【0054】とのような光通信モジュール51、61の 製造方法は、以下の順によって特徴的つけられる。

【0055】半導体電子デバイス8a、6bをフレキシ ブルブリント基板2の主面上に搭載する。 フレキシブル ブリント基板2の主面およびこの主面と対向する裏面の いずれかを対面するように、フレキシブルブリント基板 2を屈曲させる。半導体電子デバイス6a、6bを一括 してモールド封止する。モールド封止には、トランスフ ァモールド法を使用できる。フレキシブルブリント基板 2の屈曲は、トランスファモールド金型(図示せず)に 載置することによって、モールド封止中を通して容易に 維持される。

【0050】図8を参照すると、フレキシブルプリント 基板2は、上記主面が第4の領域2f および第5の領域 2gにおいて対面するように、第6の領域2hにおいて 20 折り曲げられている。光通信モジュール51は、この屈 曲状態で、第4の領域2f および第5の領域2g に形成 された樹脂体10aを備える。樹脂体10aは、半導体 電子デバイス6a、6bを一体にモールド封止する。 樹 脂体10aは、半導体光素子8が発光または受光する光 を透過させない特性を有することが好ましい。半導体電 子デバイス6a、6bを搭載した面が対面するように、 フレキシブルプリント基板2を折り曲げると、半導体電 子デバイス6a、6bが共に、フレキシブルブリント基 板2によって挟まれる。このため、いわゆるノイズ光が 30 半導体電子デバイス6a、6bに到達しにくくなる。

[0058]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の光 通信モジュールは、第1の導電層を有するフレキシブル プリント基板と、半導体光デバイスと、半導体電子デバ イスとを備える。半導体光デバイスおよび半導体電子デ バイスは封止用樹脂を用いて封止されている。フレキシ ブルブリント基板は、第1の導電層と、この第1の導電 層を支持する基体とを有する。このため、半導体光デバ イスおよび半導体電子デバイスを搭載する部材の機械的 強度の低下を考慮することなく第1の導電層を形成でき る。故に、フレキシブルプリント基板上に微細な配線を 形成可能になる。

【0051】図9を参照すると、フレキシブルブリント 基板2は、上記主面に対向する面が第4の領域2fおよ び第5の領域2gにおいて対面するように、第6の領域 2 h において折り曲げられている。光通信モジュール6 1は、この屈曲状態で、第4の領域2 f および第5の領 域2gに形成された樹脂体10bを備える。樹脂体10 bは、半導体電子デバイス6a、6bを一体にモールド 封止する。樹脂体10bは、半導体光素子8が発光また は受光する光を透過させない特性を有することが好まし 40 ル1の断面図である。 い。半導体電子デバイス8a、8bを搭載した面が対面 するように、フレキシブルブリント基板2を折り曲げる と、半導体電子デバイス8a、6bが共に、フレキシブ ルプリント基板2を挟むように配置される。このため、 半導体電子デバイス6 a、6 b間のノイズをフレキシブ ルプリント基板2上に形成されている導電層によって遮 敵するととができる。

【0057】したがって、髙機能化を図ることが可能な 光通信モジュールを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の光通信モジュールの斜視図で あり、図1では、光通信モジュールの内部が明らかにな るように一部破断図にしている。

【図2】図2は、図1の1-1断面での光通信モジュー

【図3】図3は、半導体光デバイスが搭載されたフレキ シブルブリント基板、およびトランスファモールド金型 を部分的に示す斜視図である。

【図4】図4は、樹脂封止された光通信モジュールを示 す斜視図である。

【図5】図5は、別の実施の形態を示す光通信モジュー ルの断面図であり、図5では、図1のI-I断面に相当 する断面を示している。

【図6】図6(a)は、スリーブの斜視図である。図6 (b)は、図6(a)のII-II断面における断面図

【0052】光通信モジュール51、61では、フレキ シブルプリント基板2を屈曲させた状態で複数の半導体 電子デバイス6a、6bを一体の樹脂体10a、10b 50